

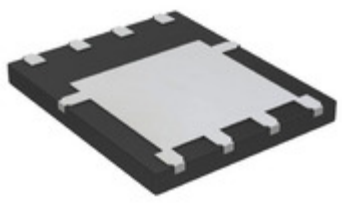
	<p>SIDR402DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIDR402DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 40V PPSO-8DC</p> <p>Datenblätter:  1.SIDR402DP-T1-GE3.pdf  2.SIDR402DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2514 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

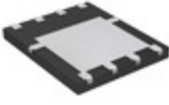
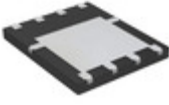
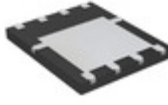
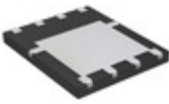
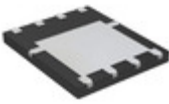

Spezifikationen

Teilenummer	SIDR402DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 40V PPSO-8DC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2514 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8DC
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.88 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	6.25W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIDR402DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9100pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	165nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 64.6A (Ta), 100A (Tc) 6.25W (Ta), 125W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	64.6A (Ta), 100A (Tc)

SIDR402DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDR402DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDR402DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIDR402DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDR140DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 25V PPAK SO-8DC</p>	 <p>SIDR622DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 150V</p>	 <p>SIDC85D170HX1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 150A WAFER</p>	 <p>SIDR638DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A SO-8</p>
 <p>SIDR668DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V</p>	 <p>SIDR610DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 200V PPAK SO-8DC</p>	 <p>SIDEGIG-GUITAREVM N/A EVALUATION MODULE</p>	 <p>SIDC85D170H Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 150A WAFER</p>

SIDR402DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIDR402DP-T1-GE3 Datenblatt	SIDR402DP-T1-GE3-Datenblätter	SIDR402DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIDR402DP-T1-GE3
SIDR402DP-T1-GE3 Electronic	SIDR402DP-T1-GE3-Komponenten	SIDR402DP-T1-GE3-Verteiler	SIDR402DP-T1-GE3-Bild	SIDR402DP-T1-GE3-Teil
SIDR402DP-T1-GE3 Preis	SIDR402DP-T1-GE3 Hersteller	SIDR402DP-T1-GE3 Bild	SIDR402DP-T1-GE3 Aktie	SIDR402DP-T1-GE3 Inventar
SIDR402DP-T1-GE3 Neu	SIDR402DP-T1-GE3 Original	SIDR402DP-T1-GE3 garantiert	SIDR402DP-T1-GE3 RFQ	SIDR402DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited